

NÔI DUNG

- 1. Tổng quan về hệ thống nhớ
- 2. Bộ nhớ bán dẫn
- 3. Bộ nhớ chính
- 4. Bộ nhớ cache
- 5. Bộ nhớ ngoài
- 6. Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân

1. Tổng quan về hệ thống nhớ

- 1. Các đặc trưng của hệ thống nhớ
- □ Vị trí
 - Bên trong CPU:
 - □ tập thanh ghi
 - Bộ nhớ trong
 - □ bộ nhớ chính□ bộ nhớ cache
 - Bộ nhớ ngoài: các thiết bị nhớ
- □ Dung lượng
 - Độ dài từ nhớ (tính bằng bit: 16, 32 bit)
 - Số lượng từ nhớ

Các đặc trưng của hệ thống nhớ (tiếp)

- □ Đơn vị truyền
 - Từ nhớ (word)
 - Khối nhớ (block)
- □ Phương pháp truy nhập
 - Truy nhập tuần tự (băng từ)
 - Truy nhập trực tiếp (các loại đĩa)
 - Truy nhập ngẫu nhiên (bộ nhớ bán dẫn)
 - Truy nhập liên kết (cache)

Các đặc trưng của hệ thống nhớ (tiếp)

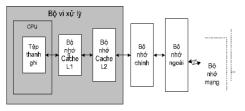
- □ Hiệu năng
 - Thời gian truy nhập
 - Chu kỳ nhớ
 - Tốc độ truyền
- □ Kiểu vật lý
 - Bộ nhớ bán dẫn
 - Bộ nhớ từ
 - Bộ nhớ quang

Các đặc trưng của hệ thống nhớ (tiếp)

- □ Các đặc tính vật lý
 - Khả biến/Không khả biến (volatile/nonvolatile)
 - Xóa được/Không xóa được
- □ Tổ chức



2. Phân cấp hệ thống nhớ



Từ trái sang phải:

- □ dung lượng tăng dân
- □ tốc độ giảm dần
- □ giá thành/1 bit giảm dần

Bộ nhớ bán dẫn

1. Phân loại

Kiểu bộ nhớ	Tiêu chuẩn	Khả năng xóa	Cơ chế ghi	Tính khả biến
Read Only Memory (ROM)	Bộ nhớ chí đọc	Không xóa được	Mặt nạ	
Programmable ROM (PROM)			Bằng điện	Không khá biến
Erasable PROM (EPROM)	Bộ nhớ hầu như chỉ đọc	Bằng tia cực tím, cả chip		
Electrically Erasable PROM (EEPROM)		Bằng điện, mức từng byte		
Flash Memory	Bộ nhớ đọc-ghi	Bằng điện, mức từng khối		
Random Access Memory (RAM)		Bằng điện, mức từng byte		Khả biến

ROM (Read Only Memory)

- □ Bộ nhớ không khả biến
- □ Lưu trữ các thông tin sau:
 - Thư viện các chương trình con
 - Các chương trình điều khiển hệ thống (BIOS)
 - Các bảng chức năng
 - Vi chương trình

Các kiểu ROM

- □ ROM mặt nạ:
 - thông tin được ghi khi sản xuất
 - rất đắt
- □ PROM (Programmable ROM)
 - Cần thiết bị chuyên dụng để ghi bằng chương trình → chỉ ghi được 1 lần
- □ EPROM (Erasable PROM)
 - Cần thiết bị chuyên dụng để ghi bằng chương trình → ghi được nhiều lần
 - Trước khi ghi lại, xóa bằng tia cực tím

Các kiểu ROM (tiếp)

- □ EEPROM (Electrically Erasable PROM)
 - Có thể ghi theo từng byte
 - Xóa bằng điện
- □ Flash Memory (Bộ nhớ cực nhanh)
 - Ghi theo khối
 - Xóa bằng điện

RAM (Random Access Memory)

- □ Bộ nhớ đọc-ghi (Read/Write Memory)
- □ Khả biến
- □ Lưu trữ thông tin tạm thời
- □ Có 2 loại: SRAM và DRAM



2

SRAM (Static RAM) - RAM tĩnh

- □ Các bit được lưu trữ bằng các Flip-Flop \rightarrow thông tin ổn định
- □ Cấu trúc phức tạp
- □ Dung lượng chip nhỏ
- □ Tốc đô nhanh
- □ Đắt tiền
- □ Dùng làm bộ nhớ cache

13

DRAM (Dynamic RAM) - RAM động

- □ Các bit được lưu trữ trên tụ điện
 - → cần phải có mạch làm tươi
- □ Cấu trúc đơn giản
- □ Dung lượng lớn
- □ Tốc độ chậm hơn
- □ Rẻ tiền hơn
- □ Dùng làm bộ nhớ chính

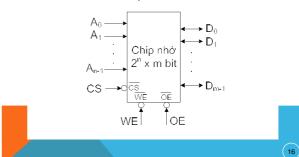
Các DRAM tiên tiến

- □ Enhanced DRAM
- □ Cache DRAM
- □ Synchronous DRAM (SDRAM): làm việc được đồng bộ bởi xung đồng hồ
- □ DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
- □ Rambus DRAM (RDRAM)

15

2. Tổ chức của chip nhớ

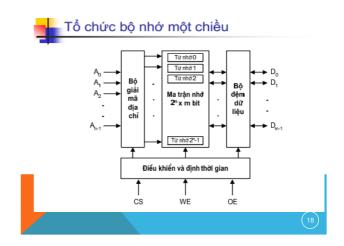
□ Sơ đồ cơ bản của chip nhớ

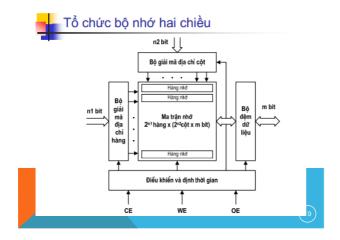


Các tín hiệu của chip nhớ

- $\hfill\Box$ Các đường địa chỉ: $A_{n\text{--}1} \div A_0 \to \text{có } 2^n \, \text{từ nhớ}$
- \square Các đường dữ liệu: $D_{m\text{-}1} \div D_0 \to \text{độ dài từ}$ nhớ = m bit
- \Box Dung lượng chip nhớ = $2^n \times m$ bit
- □ Các đường điều khiển:
 - Tín hiệu chọn chip CS (Chip Select)
 - Tín hiệu điều khiển đọc OE (Output Enable)
 - Tín hiệu điều khiển ghi WE (Write Enable)

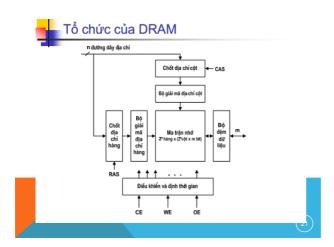
Các tín hiệu điều khiển tích cực với mức 0







- Có n đường địa chỉ: n = n1 + n2
 - 2ⁿ¹ hàng,
 - mỗi hàng có 2ⁿ² từ nhớ,
- Có m đường dữ liệu:
- mỗi từ nhớ có đô dài m-bit.
- Dung lượng của chip nhớ:
 [2ⁿ¹ x (2ⁿ² x m)] bit = (2ⁿ¹⁺ⁿ² x m) bit = (2ⁿ x m) bit.
- Hoạt động giải mã địa chỉ:
 - Bước 1: bộ giải mã hàng chọn 1 trong 2ⁿ¹ hàng.
 - Bước 2: bộ giải mã cột chọn 1 trong 2ⁿ² từ nhớ (cột) của hàng đã được chọn.

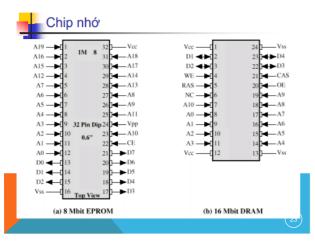


Tổ chức của DRAM

- $\hfill\Box$ Dùng n đường địa chỉ dồn kênh \to cho phép truyền 2n bit địa chỉ
- □ Tín hiệu chọn địa chỉ hàng RAS (Row Address Select)
- ☐ Tín hiệu chọn địa chỉ cột CAS (Column Address Select)
- $\hfill\Box$ Dung lượng của DRAM = $2^{2n}\times m$ bit

Cách này làm tiết kiệm số chân địa chỉ

Ví dụ; DRAM có 14 chân địa chỉ dồn kênh, 8 chân dữ liệu Dung lượng = 2^{28} x 8 bit = 2^{8} x 2²⁰ x 8 bit = 2^{50} M x 8 bit



3. Thiết kế mô-đun nhớ bán dẫn

- \Box Dung lương chip nhớ = $2^n \times m$ bit
- □ Cần thiết kế để tăng dụng lương:
 - Thiết kế tăng độ dài từ nhớ
 - Thiết kế tăng số lượng từ nhớ
 - Thiết kế kết hợp



(26)

Tăng độ dài từ nhớ

VD1:

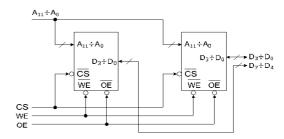
- □ Cho chip nhớ SRAM 4K x 4 bit
- □ Thiết kế mô-đun nhớ 4K x 8 bit

Giải:

- □ Dung lượng chip nhớ = 212 x 4 bit
- □ chip nhớ có:
 - 12 chân địa chỉ
 - 4 chân dữ liệu
- □ mô-đun nhớ cần có:
 - 12 chân địa chỉ
 - 8 chân dữ liêu



Tăng độ dài từ nhớ



Khi CS=0 thì cả 2 chip này cùng làm việc WE, OE chung nhau -> ghi thì cùng ghi, đọc thì cùng đọc

Bài toán tăng độ dài từ nhớ tổng quát

- □ Cho chip nhớ 2ⁿ x m bit
- □ Thiết kế mô-đun nhớ $2^n \times (k.m)$ bit
- □ Dùng k chip nhớ

27)

Tăng số lượng từ nhớ

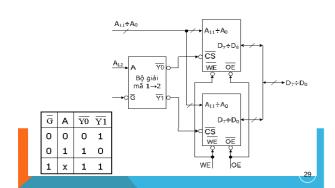
VD2:

- □ Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
- □ Thiết kế mô-đun nhớ 8K x 8 bit

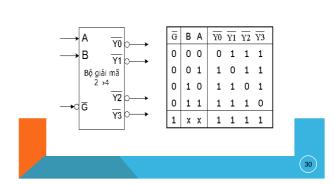
Giải:

- \Box Dung lượng chip nhớ = 2^{12} x 8 bit
- chip nhớ có:
 - 12 chân địa chỉ
 - 8 chân dữ liệu
- \Box Dung lượng mô-đun nhớ = 2^{13} x 8 bit:
 - 13 chân địa chỉ
 - 8 chân dữ liệu

Ví dụ tăng số lượng từ nhớ



Bộ giải mã 2→4



Tăng số lượng và độ dài ngăn nhớ

- Ví du 3:
 - Cho chip nhớ SRAM: 8K x 4 bit
 - Hãy thiết kế modul nhớ 16K x 8 bit
- Giải:
 - Dung lượng chip nhớ: 213 x 4 bit
 - Chip nhớ có:
 - 13 đường địa chỉ $(A_0 \div A_{12})$, 4 đường dữ liệu $(D_0 \div D_3)$
 - Modul nhớ cần có:
 - 14 đường địa chỉ $(A_0 \div A_{13})$, 8 đường dữ liệu $(D_0 \div D_7)$



Bài tập

- 1. Tăng số lượng từ nhớ gấp 4 lần:
 - Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
 - Thiết kế mô-đun nhớ 16K x 8 bit
- 2. Tăng số lượng từ nhớ gấp 8 lần:
 - Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
 - Thiết kế mô-đun nhớ 32K x 8 bit
- 3. Thiết kế kết hợp:
 - Cho chip nhớ SRAM 4K x 4 bit
 - Thiết kế mô-đun nhớ 8K x 8 bit



Bài tâp

- Bài 1: Cho IC nhớ có dung lượng 8K x 8 bit. Hãy thiết kế modul nhớ có dung lượng 8K x 32 bit.
- Bài 2: Cho IC nhớ có dung lượng 4K x 16 bit. Hãy thiết kế modul nhớ có dung lượng 16K x 16 bit.
- Bài 3: Cho IC nhớ có dung lượng 4K x 8 bit. Hãy thiết kế modul nhớ có dung lượng 32K x 8 bit.
- Bài 4: Cho IC nhớ có dung lượng 8K x 4 bit. Chỉ dùng Bộ giải mã 2:4, hãy thiết kế modul nhớ có dung lượng 16K x 4 bit.

Bài tập

- Bài 5: Cho IC nhớ có dung lượng 4K x 8 bit. Chỉ dùng Bộ giải mã 3: 8, hãy thiết kế modul nhớ có dung lượng 8K x 8 bit.
- Bài 6: Cho IC nhớ có dung lượng 2K x 8 bit. Chỉ dung Bộ giải mã 3:8, hãy thiết kế modul nhớ có dung lượng 8K x 8 bit.
- Bài 7: Cho IC nhớ có dung lượng 8K x 8 bit.
 Chỉ dùng Bộ giải mã 1:2, hãy thiết kế modul nhớ có dung lượng 32K x 8bit.

Bài tập

- Bài 8: Cho IC nhớ có dung lượng 8K x 8 bit. Chỉ dùng Bộ giải mã 1:2, hãy thiết kế modul nhớ có dung lượng 64K x 32 bit.
- Bài 9: Cho IC nhớ có dung lượng 8K x 4 bit. Chỉ dùng Bộ giải mã 2:4, hãy thiết kế modul nhớ có dung lượng 64K x 4 bit.

3. Bô nhớ chính

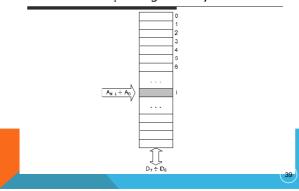
- 1. Các đặc trưng cơ bản
- Chứa các chương trình đang được thực hiện và các dữ liệu đang được sử dụng
- □ Tồn tại trên mọi hệ thống máy tính
- Bao gồm các ngăn nhớ được đánh địa chỉ trực tiếp bởi CPU
- Dung lượng của bộ nhớ chính nhỏ hơn không gian địa chỉ bộ nhớ mà CPU quản lý
- Việc quản lý logic bộ nhớ chính tùy thuộc vào hệ điều hành

2. Tổ chức bô nhớ đan xen

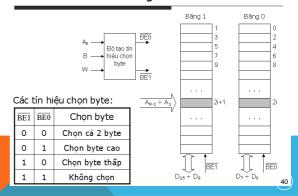
- □ Độ rộng của bus dữ liệu để trao đổi với bộ nhớ: m = 8, 16, 32, 64, 128 ... bit
- $\hfill\Box$ Các ngăn nhớ được tổ chức theo byte
 - ightarrow tổ chức bộ nhớ vật lý khác nhau



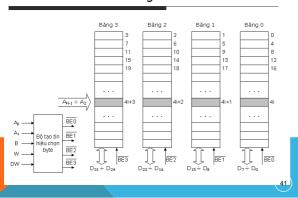
m=8 bit → một băng nhớ tuyến tính



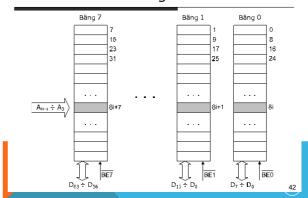
m=16 bit \rightarrow hai băng nhớ đan xen



m=32 bit \rightarrow bốn bằng nhớ đan xen

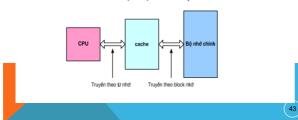


m=64 bit → tám băng nhớ



4. Bộ nhớ đệm nhanh (cache memory)

- 1. Nguyên tắc chung của cache
- Cache có tốc đô nhanh hơn bô nhớ chính
- Cache được đặt giữa CPU và bộ nhớ chính nhằm tăng tốc độ CPU truy cập bộ nhớ
- Cache có thể được đặt trên chip CPU

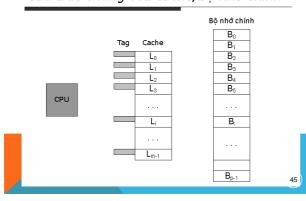


Ví dụ về thao tác của cache

- □ CPU yêu cầu nội dung của ngăn nhớ
- □ CPU kiểm tra trên cache với dữ liệu này
- □ Nếu có, CPU nhận dữ liệu từ cache (nhanh)
- Nếu không có, đọc block nhớ chứa dữ liệu từ bộ nhớ chính vào cache
- □ Tiếp đó chuyển dữ liệu từ cache vào CPU



Cấu trúc chung của cache/bộ nhớ chính



Cấu trúc chung của cache / bộ nhớ chính (tiếp)

- Bộ nhớ chính có 2^N byte nhớ
- Bộ nhớ chính và cache được chia thành các khối có kích thước bằng nhau
 - \blacksquare Bộ nhớ chính: $B_0, B_1, B_2, \dots, B_{p-1}$ (p Blocks)
 - Bộ nhớ cache: L₀, L₁, L₂, ... , L_{m-1} (m Lines)
 - Kích thước của Block = 8,16,32,64,128 byte

Cấu trúc chung của cache/bộ nhớ chính

- Một số Block của bộ nhớ chính được nạp vào các Line của cache.
- Nội dung Tag (thẻ nhớ) cho biết block nào của bộ nhớ chính hiện đang được chứa ở line đó.
- Khi CPU truy nhập (đọc/ghi) một từ nhớ, có 2 khả năng xảy ra:
 - Từ nhớ đó có trong cache (cache hit)
 - Từ nhớ đó không có trong cache (cache miss)
- Vì số line của cache ít hơn số block của bộ nhớ chính, cần có một thuật giải ánh xạ thông tin trong bộ nhớ chính vào cache.



2. Các phương pháp ánh xạ

(Chính là các phương pháp tổ chức bộ nhớ cache)

- Ánh xạ trực tiếp
 - (Direct mapping)
- Ánh xạ liên kết toàn phần
 - (Fully associative mapping)
- Ánh xạ liên kết tập hợp
 - (Set associative mapping)

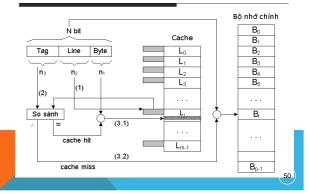


2. Các phương pháp ánh xạ địa chỉ

a) Ánh xạ trực tiếp (Direct mapping)

- Mỗi block của bộ nhớ chính chỉ có thể được nạp vào 1 line duy nhất của cache.
- - $B_{m-1} \rightarrow L_{m-1}$
 - $B_m \longrightarrow L_0$
 - $\mathsf{B}_{\mathsf{m}+1} \quad \to \mathsf{L}_1$
- \Box $L_0: B_0, B_m, B_{2m} ...$
- \Box L₁: B₁, B_{m+1}, B_{2m+1} ...
- \rightarrow B_i chỉ có thể được nạp vào L_{i mod m}

Ánh xạ trực tiếp (tiếp)



Ánh xạ trực tiếp (tiếp)

□ Địa chỉ CPU phát ra có N bit, được chia thành 3 trường:

 Trường Byte (có n₁ bit) để xác định byte nhớ trong Line (Block)

$$2^{n1}$$
 = kích thước 1 Line

■ Trường Line (có n₂ bit) để xác định Line trong Cache

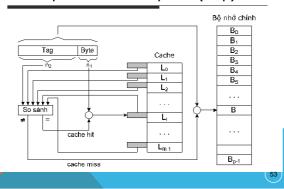
- \rightarrow Dung lượng Cache = $2^{n1} * 2^{n2} = 2^{n1+n2}$
- Trường Tag (có n₃ bit): số bit còn lại

$$n_3 = N - (n_1 + n_2) > 0 \text{ vi } 2^N >> 2^{n_1+n_2}$$

b) Ánh xạ liên kết toàn phần

- □ Fully Associative Mapping
- Mỗi block có thể được nạp vào bất kỳ line nào của cache.
- Địa chỉ bộ nhớ do CPU phát ra được chia thành
 2 phần: tag và byte.
- Dể kiểm tra xem một block có trong cache hay không, phải đồng thời kiểm tra tất cả tag của các line trong cache.
 - → Cần các mạch phức tạp để kiểm tra.

Ánh xa liên kết toàn phần (tiếp)



c) Ánh xạ liên kết tập hợp

- Set Associative Mapping
- □ Là phương pháp dung hòa của 2 phương pháp trên
- $\ \square$ Chia cache thành các tập: S_0 , S_1 , S_2 ...
- Mỗi Set có một số Line (2, 4, 8, 16 Line)
 vd mỗi Set có 2 line: 2-way Set Associative Mapping
- Mỗi block được nạp vào 1 line nào đó trong Set nhất định:

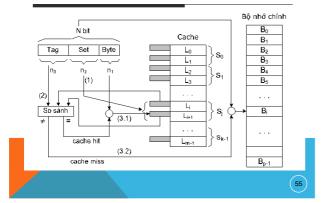
$$\begin{array}{l} B_0 \rightarrow S_0 \\ B_1 \rightarrow S_1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} B_{k-1} & \to S_{k-} \\ B_k & \to S_0 \end{array}$$

□ Địa chỉ do CPU phát ra có 3 trường: Tag, Set, Byte



Ánh xạ liên kết tập hợp (tiếp)





Đặc điểm của ánh xạ liên kết tập hợp

- Kích thước Block = 2^W Word
- Trường Set có S bit dùng để xác định một trong số V = 2^S Set
- Trường *Tag* có T bit: T = N (W+S)
- Tổng quát cho cả hai phương pháp trên
- Thông thường 2,4,8,16Lines/Set

Ví dụ

□ Hệ thống có: bộ nhớ chính = 256 MB

Cache = 128 KB Line = 16 Byte

- □ Xác định số bit của các trường địa chỉ khi
 - Ánh xạ trực tiếp
 - Ánh xạ liên kết tập hợp 4 Line/Set



Ví dụ (tiếp)

- 1) $2^{N} = 256.2^{20} = 2^{28} \rightarrow N = 28 \text{ bit}$
- Tính cho trường Byte:

Kích thước line = $16 = 2^4$ Byte $\rightarrow n_1 = 4$ bit

□ Tính cho trường Line:

Số line trong Cache: $128.2^{10}/16 = 2^{13} \rightarrow n_2 = 13$ bit

□ Tính cho trường Tag:

 $n_3 = N - (n_1 + n_2) = 28 - (4 + 13) = 11 bit$

- 2) Trường Byte: $n_1 = 4$ bit
 - Trường Set:

Số Set = Số line/4 = $2^{13}/4 = 2^{11} \rightarrow n_2 = 11$ bit

- Trường Tag: $n_3 = N - (n_1 + n_2) = 28 - (4 + 11) = 13 bit_1$

Ví du 2

Cho máy tính có dung lượng bộ nhớ chính: 256MB, cache: 128KB, line: 16B, độ dài ngăn nhớ: 2B. Trong trường hợp kỹ thuật ánh xạ trực tiếp, dạng địa chỉ do bộ xử lý phát ra để truy nhập cache là như thế nào

Giải:

1)2 N =256x2 20 /2 (vì mỗi ngăn nhớ 2B)=2 8 x2 20 /2=2 27 =>N=27 bit Tính cho trường Byte:

Kích thước Line=16B/2 (vì mỗi ngăn nhớ 2B)=2³B =>n₄=3bit

Tính cho trường Line:

Số line trong cache =128x2 10 /16=2 17 /2 4 =2 13 vậy n $_{2}$ =13

Tính cho trường Tag:

n₃=N-n₁-n₂=27-3-13=11 Két luận: n₃+n₂+n₁=11+13+3



- 3. Các thuật giải thay thế block trong cache
- Khi CPU truy nhập một thông tin mà không có trong cache (cache miss) thì nạp block chứa thông tin đó vào trong cache để thay thế block cũ trong cache.
- \square Ánh xạ trực tiếp \rightarrow chỉ có 1 cách nạp \rightarrow không cần thuật giải để nạp.
- □ 2 phương pháp ánh xạ liên kết → cần có thuật giải để lựa chọn thay thế.



Các thuật giải thay thể block trong cache (tiếp)

- 1. Random: thay block một cách ngẫu nhiên.
- FIFO (First In, First Out): thay thể block đã tồn tại lâu nhất trong toàn cache đối với ánh xạ liên kết toàn phần, trong set đối với ánh xạ liên kết tập hợp.
- LFU (Least Frequently Used): thay block có số lần truy nhập ít nhất.
- LRU (Least Recently Used): thay block có khoảng thời gian dài nhất không được truy nhập → được đánh giá là hiệu quả nhất.

4. Phương pháp ghi dữ liệu khi cache hit

- ☐ Ghi xuyên qua (Write through)
 - ghi cả cache và bộ nhớ chính
 - tốc đô châm
- □ Ghi trả sau (Write back)
 - chỉ ghi ra cache
 - tốc độ nhanh

(61)

65

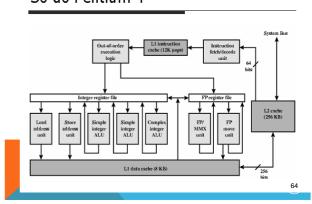
khi block trong cache bị thay thế cần phải ghi trả cả block về bộ nhớ chính



5. Cache trên các bô xử lý Intel

- □ 80386: không có cache trên chip
- □ 80486: 8KB
- □ Pentium: có 2 cache L1 trên chip
 - cache lệnh = 8KB
 - cache dữ liệu = 8KB
- □ Pentium 4: hai mức cache L1 và L2 trên chip
 - Cache L1:
 - □ 2 cache L1, mỗi cache 8KB
 - □ kích thước Line = 64 byte
 - Cache L2:
 - □ 256 KB 2 MB
 - □ kích thước Line = 128 byte

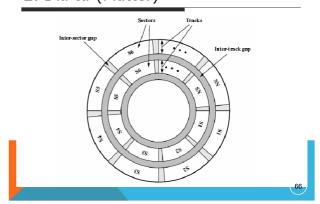
Sơ đồ Pentium 4



5. Bộ nhớ ngoài

- 1. Các kiểu bộ nhớ ngoài
- □ Đĩa từ (Magnetic Disk)
- □ Đĩa quang (Optical Disk)
- □ Flash Disk
- □ Băng từ (Magnetic Tape)

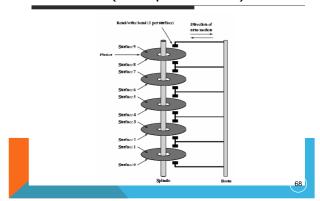
2. Đĩa từ (Platter)



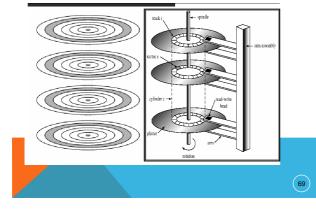
Các đặc tính đĩa từ

- □ Đầu từ cố định hay đầu từ di động
- □ Đĩa cố định hay thay đổi
- □ Một mặt hay hai mặt
- □ Môt đĩa hay nhiều đĩa
- □ Cơ chế đầu từ
 - Tiếp xúc (đĩa mềm)
 - Không tiếp xúc

Nhiều đĩa (Multiple Platters)



Cylinders



Đĩa mềm

- □ 8", 5.25", 3.5"
- □ Dung lượng nhỏ: chỉ tới 1.44 MB
- □ Tốc độ chậm (360 rpm)
- □ Thông dụng
- □ Rẻ tiền
- □ Tương lai có thể không dùng nữa?

Đĩa cứng

- □ Một hoặc nhiều đĩa
- □ Thông dụng
- □ Dung lượng tăng lên rất nhanh
 - 1993: 200 MB
 - 2005: 30 GB, 40 GB, 80 GB, 120 GB ...
- □ Tốc độ đọc/ghi nhanh (5400, 7200 rpm)
- □ Rẻ tiền



RAID

- ☐ Redundant Array of Inexpensive Disks
- □ Redundant Array of Independent Disks
- Tập các đĩa cứng vật lý được HĐH coi như một ổ logic duy nhất
- Dữ liệu được lưu trữ phân tán trên các ổ đĩa vật lý
- Có thể sử dụng dung lượng dư thừa để lưu trữ các thông tin kiểm tra chẵn lẻ, cho phép khôi phục lại thông tin trong trường hợp đĩa bị hỏng
- □ 7 loại phổ biến (RAID 0-6)



3. Đĩa quang

- □ CD-ROM (Compact Disk ROM)
- □ CD-R (Recordable CD)
- □ CD-RW (Rewriteable CD)
- □ Dung lượng thông dụng 700 MB
- □ Ő đĩa CD:
 - Ő đĩa CD-ROM
 - O CD-Writer: ghi một phiên hoặc ghi nhiều phiên
 - Ő CD-RW
- □ Tốc đô đọc cơ sở 150 KB/s
- □ Tốc độ bội, ví dụ: 48x, 52x, ...



Đĩa quang (tiếp)

□ DVD

- Digital Video Disk: chỉ dùng trên ổ đĩa xem video
- Digital Versatile Disk: ổ trên máy tính
- Ghi môt hoặc hai mặt
- Một hoặc hai lớp trên một mặt
- Thông dụng: 4,7 GB/lớp



4. Flash Disk

- □ Bộ nhớ bán dẫn cực nhanh (flash memory)
- □ Thường kết nối qua cổng USB
- □ Không phải dang đĩa
- □ Dung lượng tăng nhanh (64 MB 2 GB)
- □ Thuân tiên



SSD (Solid State Drive)

SSD là giải pháp ổ cứng thể rấn (Solid State Drive) có nhiều ưu điểm vượt trội so với HDD truyền thống.

Không giống như HDD vốn ghi dữ liệu lên các phiến đĩa mà được ghi lên các chip flash với nhiều ưu điểm vượt trội hơn như tốc độ truy xuất dữ liệu cao, chạy





6. Hệ thống nhớ trên PC hiện nay

- □ Bô nhớ cache: tích hợp trên chip vi xử lý
- □ Bộ nhớ chính: tồn tại dưới dạng các mô-đun nhớ RAM
 - SIMM Single Inline Memory Module
 - □ 30 chân: 8 đường dữ liệu □ 72 chân: 32 đường dữ liệu
 - DIMM Dual Inline Memory Module
 - □ 168 chân: 64 đường dữ liệu
 - RIMM Rambus DRAM

Hệ thống nhớ trên PC (tiếp)

- □ ROM BIOS chứa các chương trình sau:
 - Chương trình POST (Power On Self Test)
 - Chương trình CMOS Setup
 - Chương trình Bootstrap loader
 - Các trình điều khiển vào-ra cơ bản (BIOS)
- □ CMOS RAM:
 - Cấu hình hệ thống
 - Đồng hồ hệ thống
 - Có pin nuôi riêng
- □ Video RAM: quản lý thông tin của màn hình
- □ Các loại bộ nhớ ngoài

